

Title (en)
SEMICONDUCTOR MEMORY.

Title (de)
HALBLEITERSPEICHER.

Title (fr)
MEMOIRE A SEMI-CONDUCTEURS.

Publication
EP 0511401 A1 19921104 (EN)

Application
EP 91919797 A 19911119

Priority
JP 31461390 A 19901120

Abstract (en)
A semiconductor memory comprising a memory section (consisting of INV1 through INV4 and Tn1 through Tn4), two write-only bit lines (WBL and WBL) for writing data in the memory section, two read-only bit lines (RBL and RBL) for reading data from the memory section, and a shorting circuit (50) for shorting the two read-only bit lines to set them to the same potential in the write mode for writing data in the memory section through the write-only bit lines. Data can be read at a high speed from the same address immediately after data is written because the shorting circuit is provided. <IMAGE>

Abstract (fr)
Mémoire à semi-conducteurs comprenant une section de mémoire (allant de INV1 à INV4 et de Tn1 à Tn4), deux lignes binaire d'écriture seule (WBL et W(Booleen not)B(Booleen not)L(Booleen not)) permettant d'écrire des données dans la section de mémoire, deux lignes binaires de lecture seule (RBL et R(Booleen not)B(Booleen not)L(Booleen not)) permettant d'extraire des données de la section de mémoire, et un circuit de mise en court-circuit (50) qui met en court-circuit les deux lignes binaires de lecture seule, afin qu'elles se trouvent au même potentiel en mode écriture, pour écrire des données dans la section de mémoire par l'intermédiaire des lignes binaires d'écriture seule. Grâce au circuit de mise en court-circuit, les données peuvent être extraites à grande vitesse de la même adresse immédiatement après leur écriture.

IPC 1-7
G11C 11/41

IPC 8 full level
G11C 11/41 (2006.01); **G11C 8/16** (2006.01); **G11C 11/417** (2006.01); **H01L 27/10** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)
G11C 8/16 (2013.01 - EP US); **G11C 11/41** (2013.01 - KR)

Cited by
DE4238063A1; US5400295A; US5479369A; DE4406459A1; US5471420A; US5654914A; USRE35591E; DE4406459C2

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
WO 9209085 A1 19920529; EP 0511401 A1 19921104; EP 0511401 A4 19930421; JP 2987193 B2 19991206; JP H04184789 A 19920701; KR 0164199 B1 19991001; KR 920704302 A 19921219; US 5345425 A 19940906

DOCDB simple family (application)
JP 9101578 W 19911119; EP 91919797 A 19911119; JP 31461390 A 19901120; KR 920701704 A 19920720; US 85463892 A 19920806